

ESPECIFICACIONES

Serie		TCN4S	TCN4M	TCN4H	TCN4L
Alimentación	CA	100-240VCA 50/60 Hz			
	CA/CC	24VCA 50/60Hz, 24-48VCC			
Rango de voltaje permitido		90 a 110% rango nominal			
Consumo de energía	CA	Máx. 5VA (100-240 VCA 50/60Hz, 24VCA 50/60Hz)			
	CA/CC	Máx. 3W (24-48 VCC)			
Método de visualización		LED de 7seg. mentos (PV: rojo, SV: verde)			
Tamaño de carácter	PV(W×H)	7.0×15.0mm	9.5×20.0mm	7.0×14.6mm	11.0×22.0mm
	SV(W×H)	5.0×9.5mm	7.5×15.0mm	6.0×12.0mm	7.0×14.0mm
Tipo de entrada	RTD	DPT100Ω, Cu50Ω(max. 5 de resistencia de línea permitida por cable)			
	TC	K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR)			
Precisión de visualización*1	RTD	A temperatura ambiente (23 ±5): (±0.5% PVó ±1 , seleccione la más alta) ± 1dígito			
	TC	Fuera del rango de temperatura ambiente: (±0.5% PVó ±2 , seleccione la más alta) ± 1dígito Para la serie TCN4S-□-P, agregar ±1 por precisión estándar.			
Salida de control	Relevador	250VCA 3A 1a			
	SSR	12VCC ± 2V 20mA Máx.			
Salida de alarma		AL1, AL2 Relevador: 250VCA 1A 1a			
Método de control		Control ON/OFF ,P ,PI, PD, PID			
Histéresis		1 a 100 / (0.1 a 50.0 /) variable			
Banda proporcional(P)		0.1 a 999.9 /			
Tiempo Integral(I)		0 a 9999 seg.			
Tiempo derivativo(D)		0 a 9999 seg.			
Período de control(T)		0.5 a 120.0 seg.			
Reinicio manual		0.0 a 100.0%			
Periodo de muestreo		100ms			
Rigidez dieléctrica	CA	2000VCA 50/60Hz 1min.(entre los terminales de entrada y terminales de alimentación).			
	CA/CC	1000VCA 50/60Hz 1min.(entre los terminales de entrada y terminales de alimentación).			
Vibración		Amplitud de 0.75 mm a una frecuencia de 5 a 55Hz (por 1min.) en cada una de las direcciones X, Y, Z por 2 horas			
Ciclo de vida de relevador	Mecánico	OUT: más de 5.000.000 veces, AL1/2: Más de 5.000.000 veces			
	Eléctrico	OUT: Más de 200.000 veces (3A 250VCA carga resistiva) AL1/2: Más de 300.000 veces (1A 250VCA carga resistiva)			
Resistencia de aislamiento		Min.100MΩ (a 500VCC megger)			
Inmunidad al ruido		Onda cuadrada de ruido por simulador (ancho de pulso 1μs)± 2kV R-fase y fases			
Retención de memoria		Aprox.10 años (cuando se utiliza el tipo de memoria de semiconductor no-volátil)			
Ambiente	Temperatura ambiente	-10 a 50 , almacenamiento: -20 a 60			
	Humedad ambiente	35 a 85% RH, almacenamiento: 35 a 85% RH			
Tipo de aislamiento		Doble aislamiento ó aislamiento reforzado (marca: □, rigidez dieléctrica entre la medición parte de entrada y la parte de energía: 2kV de corriente alterna, corriente CA/CC 1kV)			
Certificación		    			
Peso *2		Aprox. 147g	Aprox. 203g	Aprox. 194g	Aprox. 275g
		(Aprox. 100g)	(Aprox. 133g)	(Aprox. 124g)	(Aprox. 179g)

*1: ☉ Temperatura ambiente (23 ± 5)

- Bajo 200 de termopares R(PR), S(PR) es (PV ± 0.5% ó ±3 , el mayor) ± 1 dígito
- Sobre 200 de termopares R(PR), S(PR) es (PV ± 0.5% ó ± 2° C, el mayor) ± 1 dígito
- Termopares L(IC), RTD Cu50Ω es (PV ± 0.5% ó ± 2 , el mayor) ± 1 dígito

☉ Fuera del rango de la temperatura ambiente

- Bajo 200 de termopares R(PR), S(PR) es (PV ± 1.0% ó ± 6 , el mayor) ± 1 dígito
- Sobre 200 de termopares R(PR), S(PR) es (PV ± 0.5% ó ± 5 , el mayor) ± 1 dígito
- Termopares L(IC), RTD Cu50Ω es (PV ± 0.5% ó ± 3 , el mayor) ± 1 dígito

Para la serie TCN4S-□-P, agregar ±1 por precisión estándar.

*2: El peso entre paréntesis es sólo el peso de la unidad.

* La resistencia ambiental se encuentra en estado sin congelación o condensación.